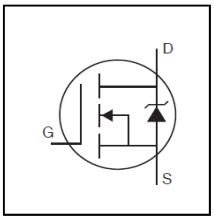
## 特性

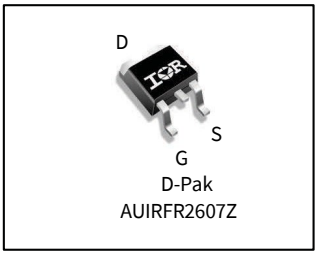
- 先进工艺技术
- 超低导通电阻
- 工作温度 175°C
- 快速开关
- 允许达到 Tjmax 的重复雪崩
- 无铅，符合RoHS要求
- 汽车认证 *




| | | |
|---|---|---|
| $V_{DSS}$ | | 75V |
| $R_{DS(on)}$ | typ. | 17.6mΩ |
| | max. | 22mΩ |
| $I_{D\ (Silicon\ Limited)}$ | | 45A⑨ |
| $I_{D\ (Package\ Limited)}$ | | 42A |

## 描述

这款 HEXFET® 功率MOSFET专为汽车应用而设计，采用最新的工艺技术实现单位硅面积极低的导通电阻。该设计的其他特点包括 175°C 工作结温、开关速度快和提高重复雪崩额定值。通过结合以上特点，使该设计成为一种极其高效和可靠的器件，可用于汽车应用和各种其他应用。




| G | D | S |
|---|---|---|
| Gate | Drain | Source |

| Base part number | Package Type | Standard Pack | | Orderable Part Number |
|---|---|---|---|---|
| | | Form | Quantity | |
| AUIRFR2607Z | D-Pak | Tube | 75 | AUIRFR2607Z |
| | | Tape and Reel Left | 3000 | AUIRFR2607ZTRL |

## 绝对最大额定值

超过“绝对最大额定值”所列值的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅仅是应力额定值，并不意味着器件在这些或任何其他超过该规范所示的条件下能够正常运行。延长暴露在绝对最大额定值条件的时间可能会影响器件的可靠性。热阻抗和功率耗散额定值是在装板和静止空气条件下测得的。环境温度（TA）为 25°C，除非另有规定。

| Symbol | Parameter | Max. | Units |
|---|---|---|---|
| $I_D$ @ $T_C$ = 25°C | Continuous Drain Current, $V_{GS}$ @ 10V (Silicon Limited) | 45⑨ | A |
| $I_D$ @ $T_C$ = 100°C | Continuous Drain Current, $V_{GS}$ @ 10V (Silicon Limited) | 32 | |
| $I_D$ @ $T_C$ = 25°C | Continuous Drain Current, $V_{GS}$ @ 10V (Package Limited) | 42 | |
| $I_{DM}$ | Pulsed Drain Current ① | 180 | |
| $P_D$ @$T_C$ = 25°C | Maximum Power Dissipation | 110 | W |
| | Linear Derating Factor | 0.72 | W/°C |
| $V_{GS}$ | Gate-to-Source Voltage | ± 20 | V |
| $E_{AS}$ | Single Pulse Avalanche Energy (Thermally Limited) ② | 96 | mJ |
| $E_{AS}$ (Tested) | Single Pulse Avalanche Energy Tested Value ⑥ | 96 | |
| $I_{AR}$ | Avalanche Current ① | See Fig.15,16, 12a, 12b | A |
| $E_{AR}$ | Repetitive Avalanche Energy ⑤ | | mJ |
| $T_J$<br>$T_{STG}$ | Operating Junction and<br>Storage Temperature Range | -55 to + 175 | °C |
| | Soldering Temperature, for 10 seconds (1.6mm from case) | 300 | |

### 热阻抗

| Symbol | Parameter | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|
| $R_{\theta JC}$ | Junction-to-Case ⑧ | --- | 1.38 | °C/W |
| $R_{\theta JA}$ | Junction-to-Ambient ( PCB Mount) ⑦ | --- | 50 | |
| $R_{\theta JA}$ | Junction-to-Ambient | --- | 110 | |

HEXFET® 是英飞凌的注册商标。

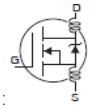
*认证标准可在 www.infineon.com 上找到

***本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。 为确认准确性，请务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本（控制文档）。***

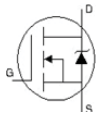
## 静态参数特性在 $T_J$ = 25°C 时测得（除非另有规定）

| | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $V_{(BR)DSS}$ | Drain-to-Source Breakdown Voltage | 75 | --- | --- | V | $V_{GS}$ = 0V, $I_D$ = 250µA |
| $\Delta V_{(BR)DSS}/\Delta T_J$ | Breakdown Voltage Temp. Coefficient | --- | 0.074 | --- | V/°C | Reference to 25°C, $I_D$ = 1mA |
| $R_{DS(on)}$ | Static Drain-to-Source On-Resistance | --- | 17.6 | 22 | mΩ | $V_{GS}$ = 10V, $I_D$ = 30A ③ |
| $V_{GS(th)}$ | Gate Threshold Voltage | 2.0 | --- | 4.0 | V | $V_{DS}$ = $V_{GS}$, $I_D$ = 50µA |
| gfs | Forward Trans conductance | 36 | --- | --- | S | $V_{DS}$ = 25V, $I_D$ = 30A |
| $I_{DSS}$ | Drain-to-Source Leakage Current | --- | --- | 20 | µA | $V_{DS}$ = 75 V, $V_{GS}$ = 0V |
| | | --- | --- | 250 | | $V_{DS}$ = 75V,$V_{GS}$ = 0V,$T_J$ =125°C |
| $I_{GSS}$ | Gate-to-Source Forward Leakage | --- | --- | 200 | nA | $V_{GS}$ = 20V |
| | Gate-to-Source Reverse Leakage | --- | --- | -200 | | $V_{GS}$ = -20V |

## 动态电气特性在 $T_J$ = 25°C时测得（除非另有规定）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Q_g$ | Total Gate Charge | --- | 34 | 51 | nC | $I_D$ = 30A $V_{DS}$ = 60V $V_{GS}$ = 10V③ |
| $Q_{gs}$ | Gate-to-Source Charge | --- | 8.9 | --- | | |
| $Q_{gd}$ | Gate-to-Drain Charge | --- | 14 | --- | | |
| $t_{d(on)}$ | Turn-On Delay Time | --- | 14 | --- | ns | $V_{DD}$ = 38V $I_D$ = 30A $R_G$ = 15Ω $V_{GS}$ = 10V③ |
| $t_r$ | Rise Time | --- | 59 | --- | | |
| $t_{d(off)}$ | Turn-Off Delay Time | --- | 39 | --- | | |
| $t_f$ | Fall Time | --- | 28 | --- | | |
| $L_D$ | Internal Drain Inductance | --- | 4.5 | --- | nH | Between lead, 6mm (0.25in.) from package and center of die contact  |
| $L_S$ | Internal Source Inductance | --- | 7.5 | --- | | |
| $C_{iss}$ | Input Capacitance | --- | 1440 | --- | pF | $V_{GS}$ = 0V $V_{DS}$ = 25V ƒ = 1.0MHz |
| $C_{oss}$ | Output Capacitance | --- | 190 | --- | | |
| $C_{rss}$ | Reverse Transfer Capacitance | --- | 110 | --- | | |
| $C_{oss}$ | Output Capacitance | --- | 720 | --- | | $V_{GS}$ = 0V, $V_{DS}$ = 1.0V ƒ = 1.0MHz |
| $C_{oss}$ | Output Capacitance | --- | 130 | --- | | $V_{GS}$ = 0V, $V_{DS}$ = 60V ƒ = 1.0MHz |
| $C_{oss\ eff.}$ | Effective Output Capacitance | --- | 230 | --- | | $V_{GS}$ = 0V, $V_{DS}$ = 0V to 60V ④ |

## 二极管特性

| | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_S$ | Continuous Source Current (Body Diode) | --- | --- | 45⑨ | A | MOSFET symbol showing the integral reverse p-n junction diode.  |
| $I_{SM}$ | Pulsed Source Current (Body Diode) ① | --- | --- | 180 | | |
| $V_{SD}$ | Diode Forward Voltage | --- | --- | 1.3 | V | $T_J$ = 25°C,$I_S$ = 30A,$V_{GS}$ = 0V ③ |
| $t_{rr}$ | Reverse Recovery Time | --- | 30 | 45 | ns | $T_J$ = 25°C ,$I_F$ = 30A, $V_{DD}$ = 38V di/dt = 100A/µs③ |
| $Q_{rr}$ | Reverse Recovery Charge | --- | 28 | 42 | nC | |
| $t_{on}$ | Forward Turn-On Time | Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by $L_S$+$L_D$) | | | | |

**注:**

① 重复额定值；脉冲宽度受最高结温限制。（见图11）

② 受 $T_{Jmax}$限制，初始 $T_J$ = 25°C、L = 0.21mH、$R_G$ = 25Ω、$I_{AS}$ = 30A、$V_{GS}$=10V。不建议在高于此值的情况运行器件。

③ 脉冲宽度≤ 1.0ms；占空比≤ 2%。

④ $C_{oss}$ eff. 是一个固定电容值， 当 $V_{DS}$ 从 0 上升至 80% $V_{DSS}$时, 其充电时间与$C_{oss}$ 相同 。

⑤ 受$T_{Jmax}$ 限制 ，典型重复的雪崩性能见图12a、12b、15、16。

⑥ 该值由样片故障总数决定。生产环境100%按照此值进行测试。

⑦ 安装在 1 英寸方形PCB （FR-4 或 G-10 材料）上时。有关推荐的封装和焊接技术，请参阅应用注释 #AN-994

⑧ $R_\theta$ 在 $T_J$ 约 90°C 时测得

⑨ 根据最大允许结温计算连续电流。封装限制电流为 42A。

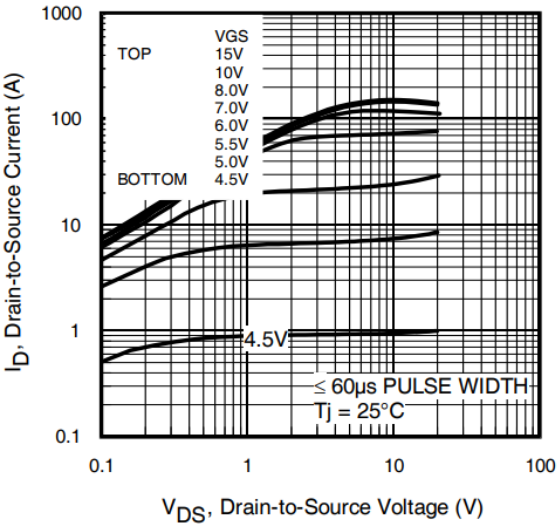



**图 1**典型输出特性

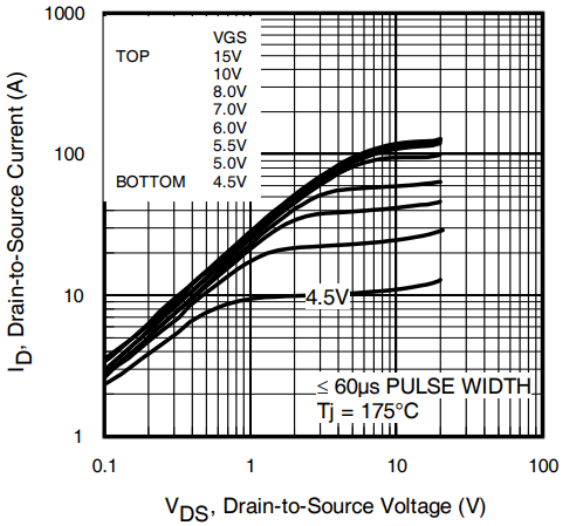



**图 2**典型输出特性

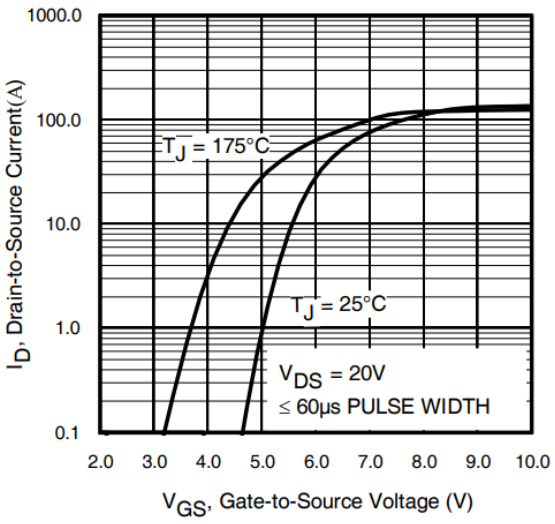



**图 3**典型转移特性

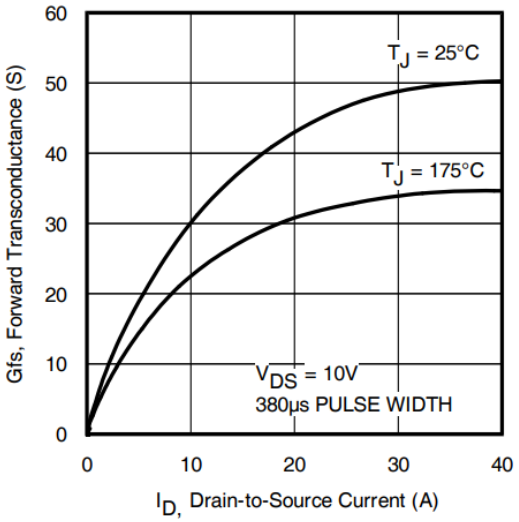



**图 4**典型正向跨导与漏极电流关系曲线

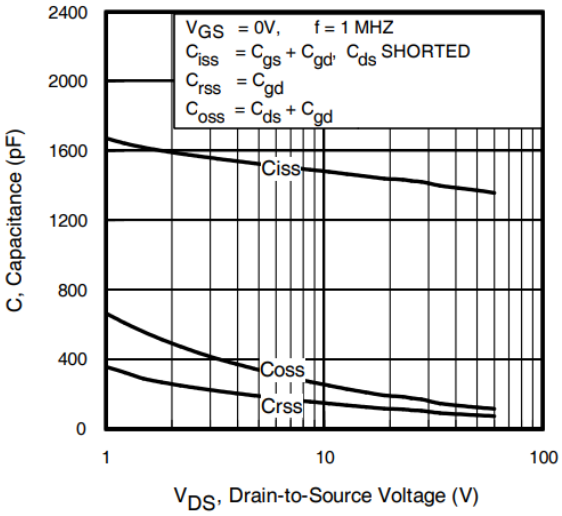



**图 5.**典型电容与漏源电压关系曲线

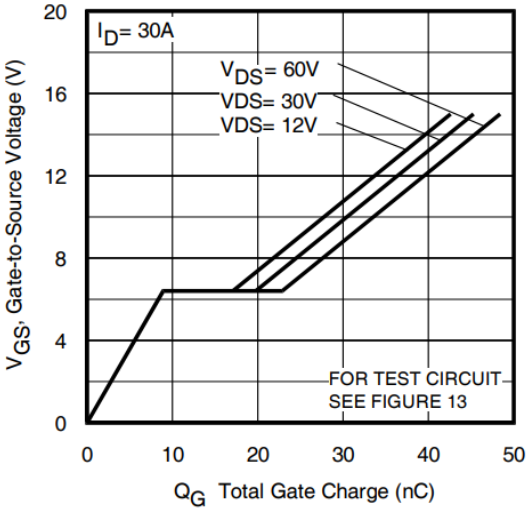



**图 6.**典型栅极电荷与栅源电压关系曲线

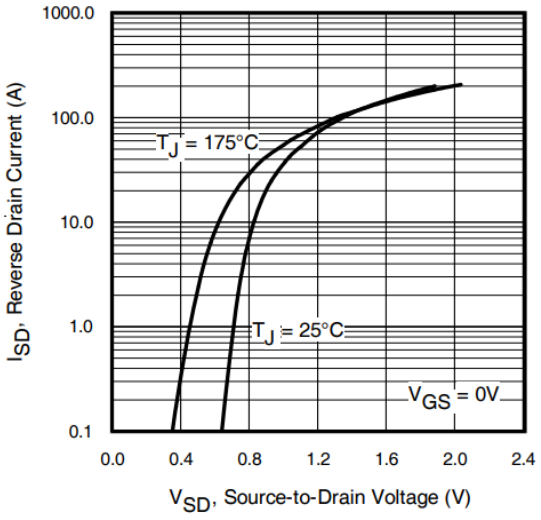



**图 7**典型源漏二极管正向电压

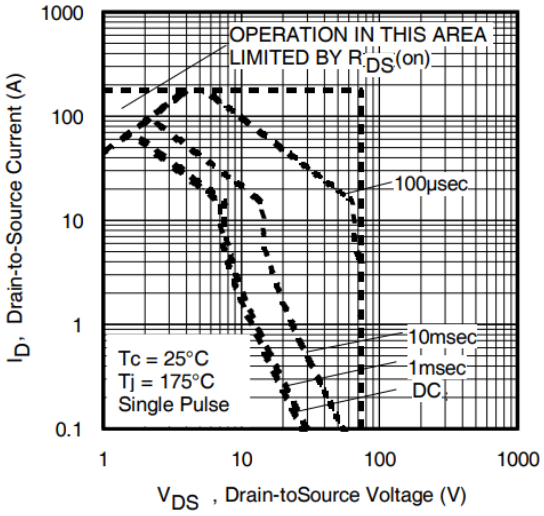



**图 8.**最大安全工作区

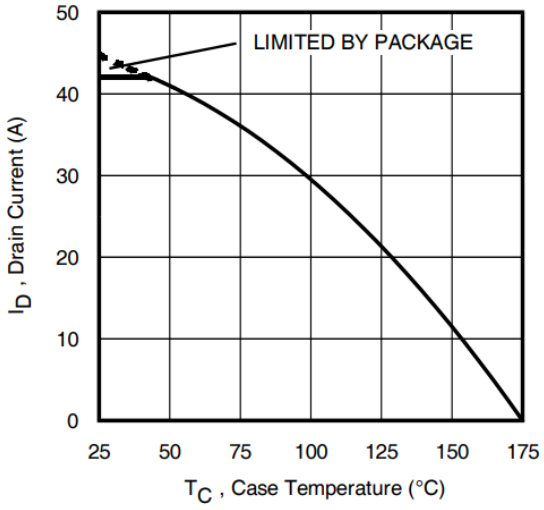



**图 9.**最大漏极电流与壳温

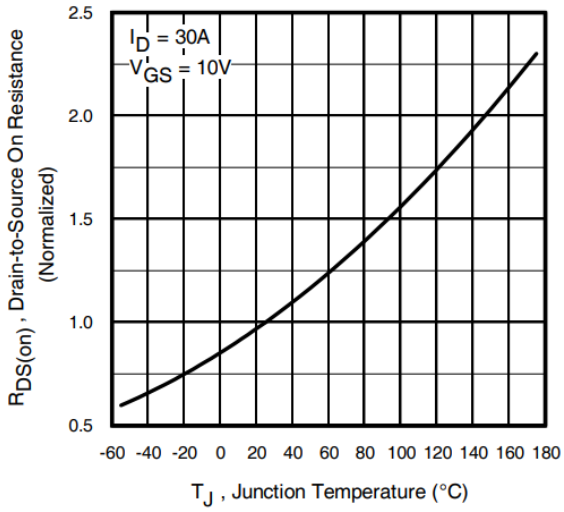
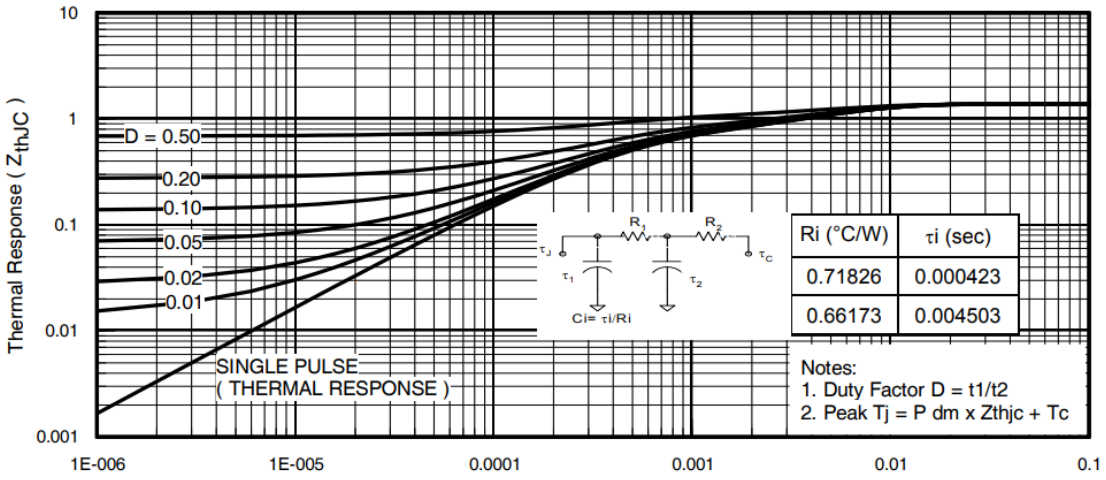



**图 10.**归一化导通电阻与温度的关系曲线




t1，矩形脉冲持续时间（秒）

**图 11.**最大有效瞬态热阻，结到壳

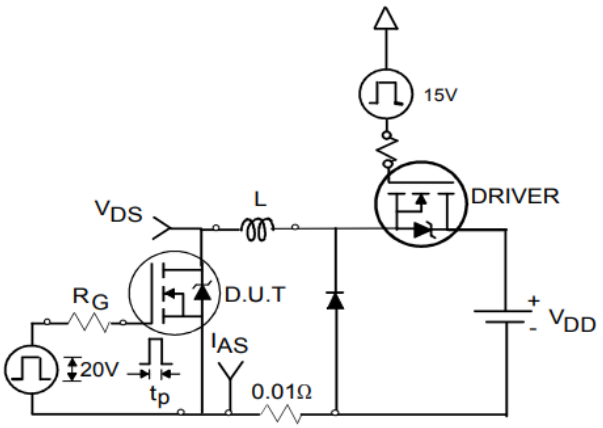



**Fig 12a.** Unclamped Inductive Test Circuit

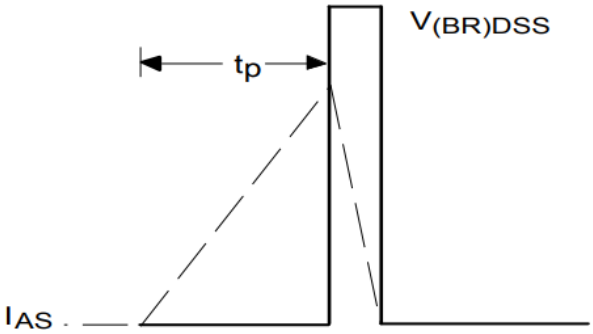



**Fig 12b.** Unclamped Inductive Waveforms

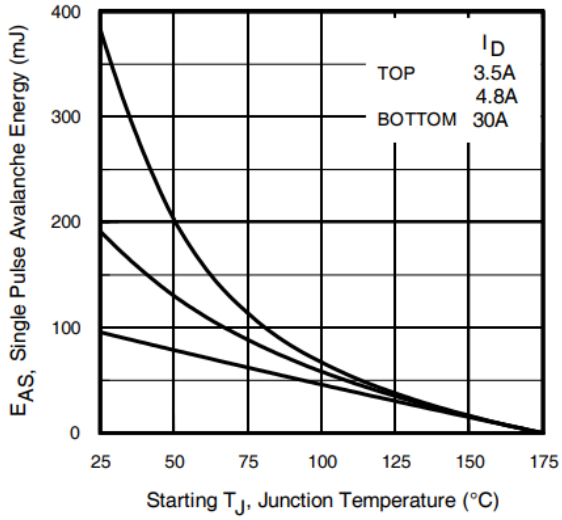



**Fig 12c.** Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current

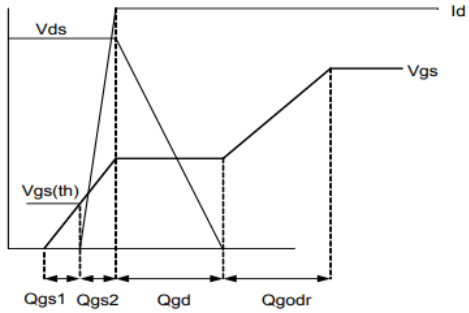



**Fig 13a.** Gate Charge Waveform

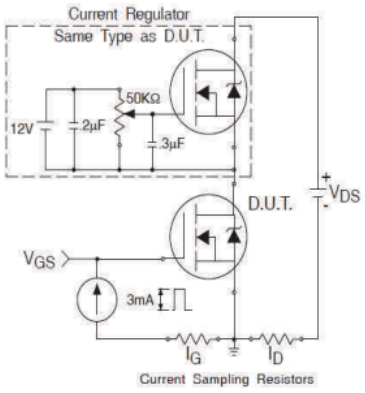



**Fig 13b.** Gate Charge Test Circuit

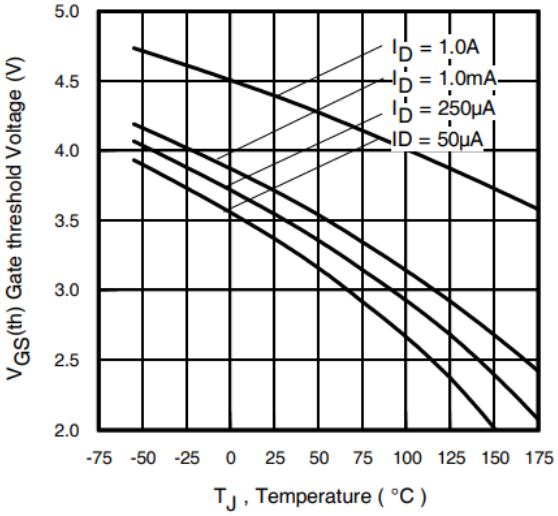



**Fig 14.** Threshold Voltage Vs. Temperature

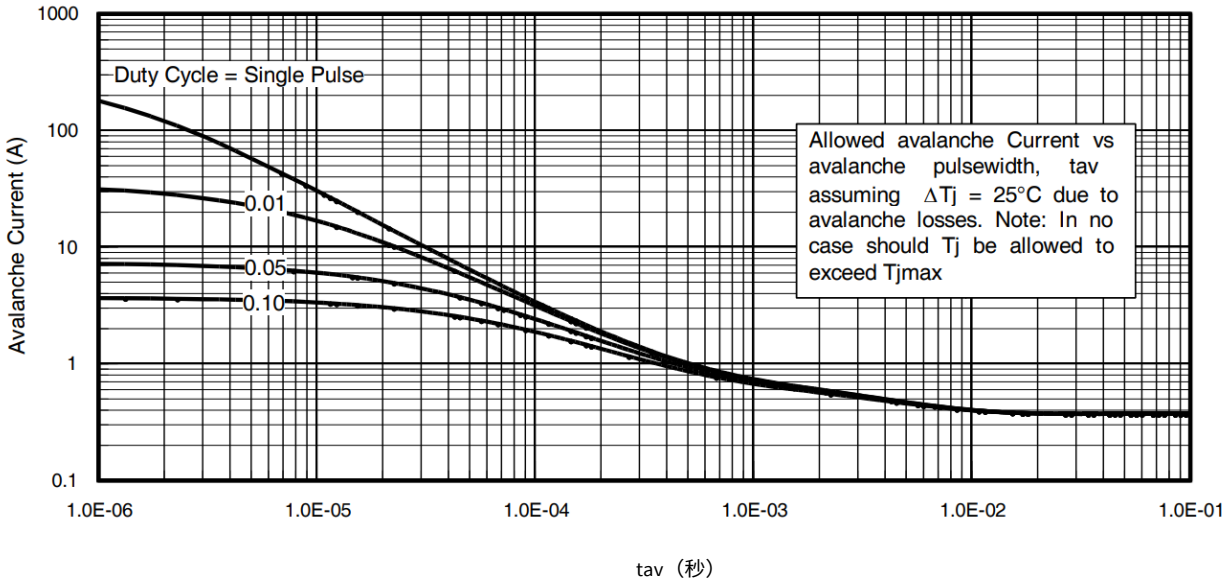



**图 15.**典型雪崩电流与脉冲宽度

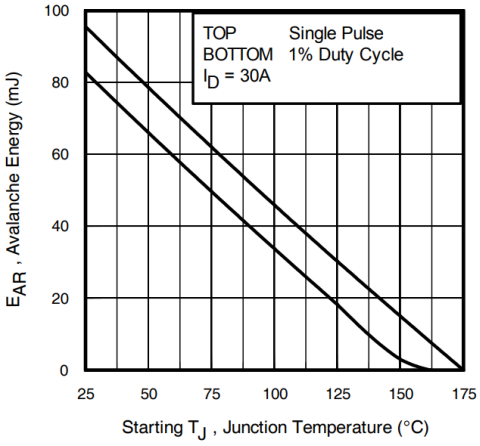



**图 16.**最大雪崩能量与温度的关系曲线

**关于重复的雪崩曲线的注释，图 15、16：（有关更多信息，请参阅www.infineon.com 上的 AN-1005）**

1. 雪崩失效假设：
   纯粹的热现象和失效发生在结温远超 T jmax的情况下。这对每种零件类型都是有效的。
2. 只要不超过 Tjmax，就可以在雪崩中安全运行。
3. 如下公式基于图 12a、12b 所示的电路和波形。
4. PD (ave) = 每个雪崩脉冲的平均功率耗散。
5. BV = 额定击穿电压（1.3 倍系数，考虑雪崩期间的电压增加）。
6. Iav = 可允许的雪崩电流。
7. ΔT = 可允许的结温上升，不得超过 T jmax （图 15、16 中假设为 25°C）。

   t av =雪崩的平均时间。

   D = 雪崩占空比 = t av ·f

   Z thJC (D, t av ) = 瞬态热阻抗，见图 13)

$$P_{D\,(ave)} = 1/2\,(1.3 \cdot BV \cdot I_{av}) = \Delta T / Z_{thJC}\, I_{av} = 2\Delta T / [1.3 \cdot BV \cdot Z_{th}]$$

$$E_{AS\,(AR)} = P_{D\,(ave)} \cdot t_{av}$$

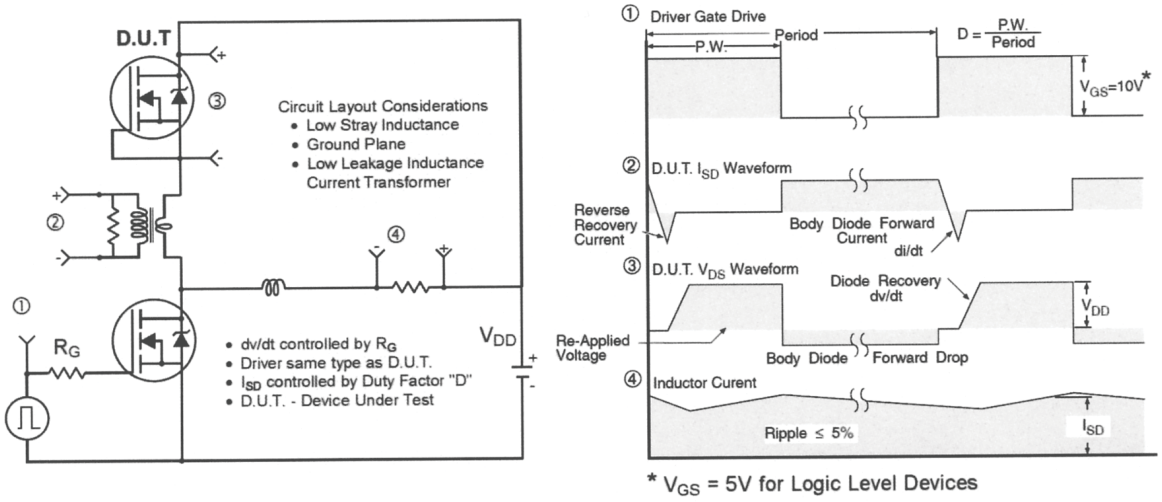



**图 17.** N 沟道 HEXFET® 功率 MOSFET 体内二极管峰值恢复 dv/dt 测试电路

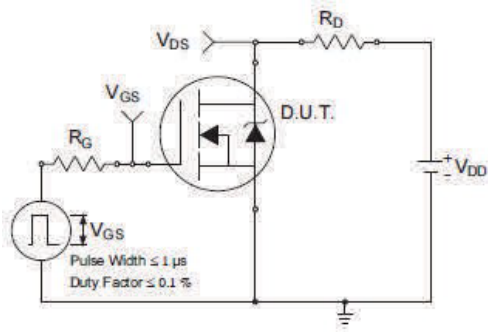



**图 18a.**开关时间测试电路

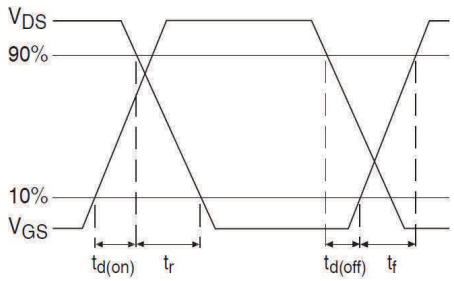
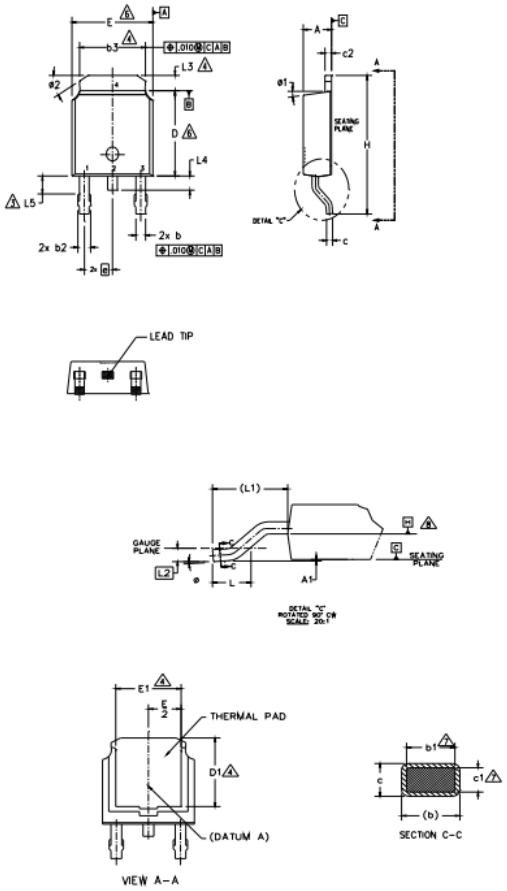



**图 18b.**开关时间波形

**D-Pak (TO-252AA) 封装外形**（尺寸以毫米（英寸）为单位）




NOTES:

1.– DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M–1994

2.– DIMENSION ARE SHOWN IN INCHES [MILLIMETERS].

3.– LEAD DIMENSION UNCONTROLLED IN L5.

4.– DIMENSION D1, E1, L3 & b3 ESTABLISH A MINIMUM MOUNTING SURFACE FOR THERMAL PAD.

5.– SECTION C–C DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN .005 AND 0.10 [0.13 AND 0.25] FROM THE LEAD TIP.

6.– DIMENSION D & E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH SHALL NOT EXCEED .005 [0.13] PER SIDE. THESE DIMENSIONS ARE MEASURED AT THE OUTMOST EXTREMES OF THE PLASTIC BODY.

7.– DIMENSION b1 & c1 APPLIED TO BASE METAL ONLY.

8.– DATUM A & B TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H.

9.– OUTLINE CONFORMS TO JEDEC OUTLINE TO–252AA.

| SYMBOL | DIMENSIONS | | | | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| | MILLIMETERS | | INCHES | | |
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | |
| A | 2.18 | 2.39 | .086 | .094 | |
| A1 | – | 0.13 | – | .005 | |
| b | 0.64 | 0.89 | .025 | .035 | |
| b1 | 0.65 | 0.79 | .025 | .031 | 7 |
| b2 | 0.76 | 1.14 | .030 | .045 | |
| b3 | 4.95 | 5.46 | .195 | .215 | 4 |
| c | 0.46 | 0.61 | .018 | .024 | |
| c1 | 0.41 | 0.56 | .016 | .022 | 7 |
| c2 | 0.46 | 0.89 | .018 | .035 | |
| D | 5.97 | 6.22 | .235 | .245 | 6 |
| D1 | 5.21 | – | .205 | – | 4 |
| E | 6.35 | 6.73 | .250 | .265 | 6 |
| E1 | 4.32 | – | .170 | – | 4 |
| e | 2.29 BSC | | .090 BSC | | |
| H | 9.40 | 10.41 | .370 | .410 | |
| L | 1.40 | 1.78 | .055 | .070 | |
| L1 | 2.74 BSC | | .108 REF. | | |
| L2 | 0.51 BSC | | .020 BSC | | |
| L3 | 0.89 | 1.27 | .035 | .050 | 4 |
| L4 | – | 1.02 | – | .040 | |
| L5 | 1.14 | 1.52 | .045 | .060 | 3 |
| ø | 0° | 10° | 0° | 10° | |
| ø1 | 0° | 15° | 0° | 15° | |
| ø2 | 25° | 35° | 25° | 35° | |

LEAD ASSIGNMENTS

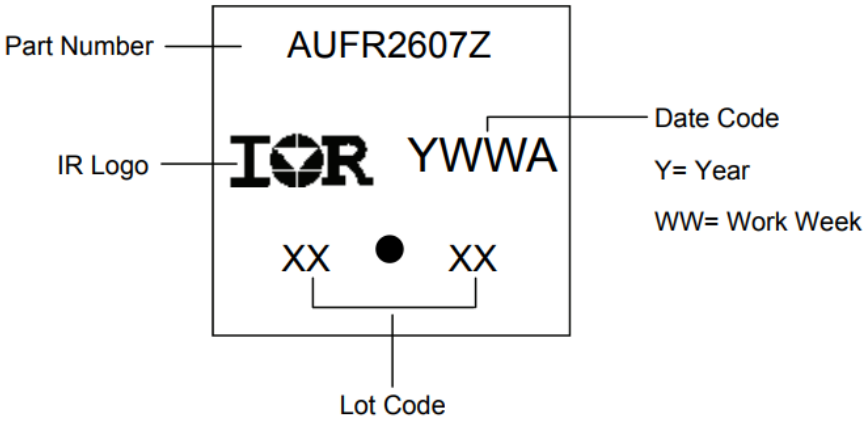
HEXFET

1.– GATE
2.– DRAIN
3.– SOURCE
4.– DRAIN

IGBT & CoPAK

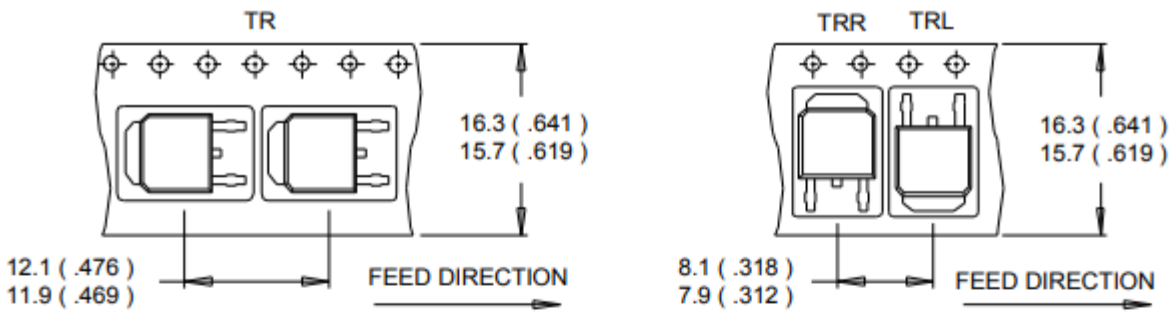
1.– GATE
2.– COLLECTOR
3.– EMITTER
4.– COLLECTOR

**D-Pak (TO-252AA) 零件标识信息**

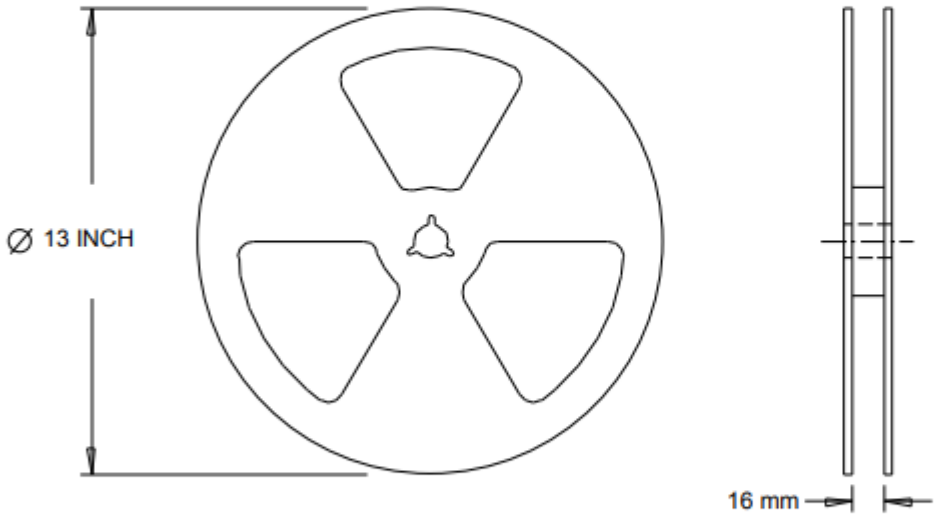



Note: For the most current drawing please refer to IR website at http://www.irf.com/package/

**D-Pak (TO-252AA) 卷带信息**（尺寸以毫米（英寸）为单位）




NOTES :
1. CONTROLLING DIMENSION : MILLIMETER.
2. ALL DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS ( INCHES ).
3. OUTLINE CONFORMS TO EIA-481 & EIA-541.




NOTES :
1. OUTLINE CONFORMS TO EIA-481.

Note: For the most current drawing please refer to IR website at http://www.irf.com/package/

**Qualification Information**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Qualification Level** | | Automotive (per AEC-Q101) | |
| | | Comments: This part number(s) passed Automotive qualification. Infineon's Industrial and Consumer qualification level is granted by extension of the higher Automotive level. | |
| **Moisture Sensitivity Level** | | D-Pak | MSL1 |
| **ESD** | Machine Model | Class M4 (+/- 425V)† AEC-Q101-002 | |
| | Human Body Model | Class H1B (+/- 1000V)† AEC-Q101-001 | |
| | Charged Device Model | Class C5 (+/- 1125V)† AEC-Q101-005 | |
| **RoHS Compliant** | | Yes | |

† 最高通过电压。

**修订记录**

| Date | Comments |
|---|---|
| 10/12/2015 | • Updated datasheet with corporate template<br>• Corrected ordering table on page 1. |

**Published by**
**Infineon Technologies AG 81726**
**München, Germany**

**© Infineon Technologies AG 2015**
**All Rights Reserved.**

**IMPORTANT NOTICE**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

**WARNINGS**

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.

## 免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。
由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。
因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 http://www.infineon.com
英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。
**您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。**

**Trademarks**
All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

版本 **2025-10-30**

**Infineon Technologies AG** 出版，
德国 **Neubiberg 85579**

版权 © **2025 Infineon Technologies AG** 及其关联公司。
保留所有权利。

**Do you have a question about this document?**

**Email:**

erratum@infineon.com

**重要通知**

**Infineon Technologies AG** 及其关联公司（以下简称 "英飞凌"）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称 "产品"），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上述合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文档中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：
由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称"安全漏洞"），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文档包含或引用软件：
根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码(binary code)形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 **https://www.infineon.com**。